

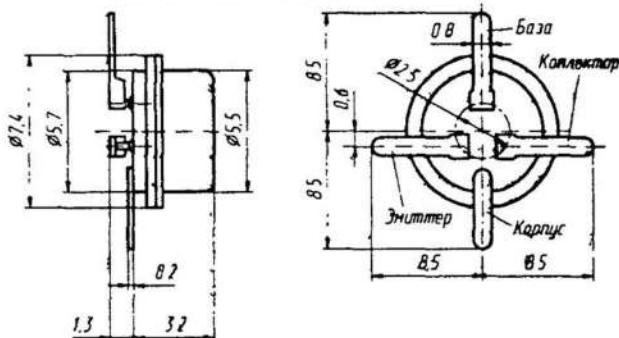
1T330А, 1T330Б, 1T330В, 1T330Г, ГТ330Д, ГТ330Ж, ГТ330И

Транзисторы германиевые планарные структуры $p-p-p$ сверхвысокочастотные усиительные с нормированным коэффициентом шума на частоте 400 МГц. Предназначены для усиления и генерирования электрических сигналов.

Выпускаются в металлокстеклянном корпусе с гибкими полосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе. Допускается маркировка транзисторов условным обозначением и цветной точкой, которую наносят на фланец ножки между корпусным и коллекторным выводами следующим образом: 1T330А — буквой «А» и красной точкой; 1T330Б — буквой «Б» и зеленой точкой; 1T330В — буквой «В» и белой точкой; 1T330Г — буквой «Г» и черной точкой.

Масса транзистора не более 2 г.

1T330(А-Г), ГТ330(Д-И)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока

при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 5$ мА:

$T = +25$ °C:

1T330А, 1T330Б, 1T330Г, ГТ330Д,	30...400
ГТ330Ж	80...400
1T330В	10...400

типовые значения:

1T330А	75*
1T330Б	180*
1T330В	140*
1T330Г	55*

Границчная частота коэффициента передачи

тока при $U_{KB} = 5$ В, $I_3 = 5$ мА, не менее:

1T330А, 1T330Б, ГТ330Ж	1000 МГц
1T330Б	1500 МГц
1T330Г	700 МГц

ГТ330Д, ГТ330И	500 МГц
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте при $U_{KB} = 5$ В, $I_B = 5$ мА, не более:	
1T330A	25 пс
1T330Б	50 пс
1T330В, ГТ330Ж	100 пс
1T330Г, ГТ330Д, ГТ330И	30 пс
Время рассасывания при $I_C = 20$ мА, $I_E = 2$ мА для 1T330A, 1T330Г, не более	50 нс
Коэффициент шума при $U_{KB} = 5$ В, $I_B = 5$ мА, $f = 400$ МГц:	
1T330A, не более	5 дБ
типовое значение.....	3,9* дБ
ГТ330Д, ГТ330И, не более	8 дБ
Граничное напряжение при $I_B = 5$ мА для 1T330A, 1T330Г, не менее	6 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_C = 20$ мА, $I_E = 2$ мА для 1T330A, 1T330Г, ГТ330Д, ГТ330И, не более	0,3 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_C = 20$ мА, $I_E = 2$ мА для 1T330A, 1T330Г, ГТ330Д, ГТ330И, не более	0,7 В
Обратный ток коллектора при $U_{KB} = 10$ В: $T = +25$ °С:	
1T330A	0,07*...0,14*...
5 мкА	
1T330Б	0,07*...0,14*...
5 мкА	
1T330В	0,08*...0,15*...
5 мкА	
1T330Г	0,08*...0,17*...
5 мкА	
ГТ330Д, ГТ330Ж, ГТ330И, не более	5 мкА
$T = -60$ °С, не более	5 мкА
$T = +70$ °С, не более	50 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{BE} = 1,5$ В, не более	100 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 5$ В, не более:	
1T330A, 1T330Б, 1T330В	2 пФ
1T330Г, ГТ330Д, ГТ330Ж, ГТ330И	3 пФ
типовые значения:	
1T330A, 1T330Б	1,7* пФ
1T330В	1,6* пФ

1T330Г	1,75* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{36} = 0,5$ В, не более	5 пФ
типовые значения:	
1T330A	1,6* пФ
1T330B	1,5* пФ
1T330B	1,45* пФ
1T330Г	1,8* пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

1T330A, 1T330B, 1T330B, 1T330Г	13 В
ГТ330Д, ГТ330Ж, ГТ330И	10 В

Импульсное напряжение коллектор—база:

при $T = -60 \dots +45$ °С:

1T330A, 1T330B, 1T330B	20 В
1T330Г	18 В

при $T = -45 \dots +55$ °С для ГТ330Д, ГТ330Ж,
ГТ330И

20 В

при $T = +70$ °С:

1T330A, 1T330B, 1T330B	15 В
1T330Г	13 В

Постоянное напряжение эмиттер—база

1,5 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер

для 1T330A, 1T330B, 1T330B, 1T330Г

13 В

Постоянный ток коллектора

20 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллек-

тора:

при $T = -60 \dots +45$ °С для 1T330A, 1T330B,
1T330B, 1T330Г

50 мВт

при $T = -45 \dots +45$ °С для ГТ330Д, ГТ330Ж,
ГТ330И

50 мВт

при $T = +55$ °С для ГТ330Д, ГТ330Ж,
ГТ330И

40 мВт

при $T = +70$ °С для 1T330A, 1T330B,
1T330B, 1T330Г

25 мВт

Температура $p-n$ перехода:

1T330A, 1T330B, 1T330B, 1T330Г

+95 °С

ГТ330Д, ГТ330Ж, ГТ330И

+60 °С

Температура окружающей среды:

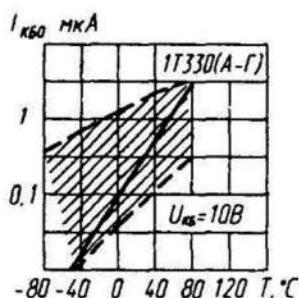
1T330A, 1T330B, 1T330B, 1T330Г

-60...+70 °С

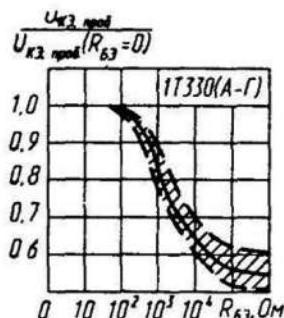
ГТ330Д, ГТ330Ж, ГТ330И

-45...+60 °С

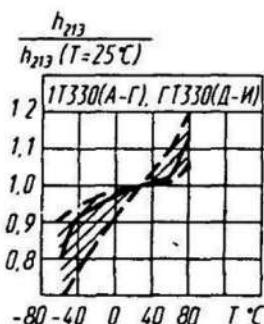
Допускается пайка полосковой части вывода в течение не
более 3 с, температура пайки не должна превышать +260 °С.



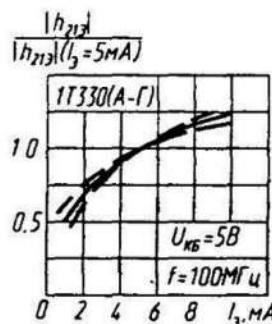
Зона возможных положений
зависимости обратного тока
коллектора от температуры



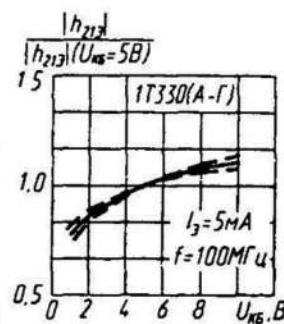
Зона возможных положений
зависимости пробивного на-
пряжения коллектор—эмит-
тер от сопротивления база—
эмиттер



Зона возможных поло-
жений зависимости ста-
тического коэффициен-
та передачи тока от
температуры



Зона возможных поло-
жений зависимости ста-
тического коэффициен-
та передачи тока от то-
ка эмиттера



Зона возможных поло-
жений зависимости ста-
тического коэффициен-
та передачи тока от на-
пряженя коллектор—
база